

2N5397, 2N5398

N-Channel Silicon Junction Field-Effect Transistor

- VHF Amplifiers
- Oscillators
- Mixers
- Low-Noise, High Power Gain
- High Transconductance

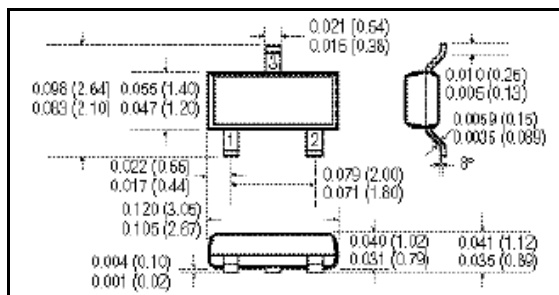
Absolute maximum ratings at $T_A = 25^\circ\text{C}$

Reverse Gate Source & Gate Drain Voltage	-25V
Continuous Forward Gate Current	10 mA
Continuous Device Power Dissipation	300 mW
Power Derating	1.7 mW/ $^\circ\text{C}$
Operating Temperature Range	-55 $^\circ\text{C}$ to +125 $^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	-65 $^\circ\text{C}$ to +150 $^\circ\text{C}$

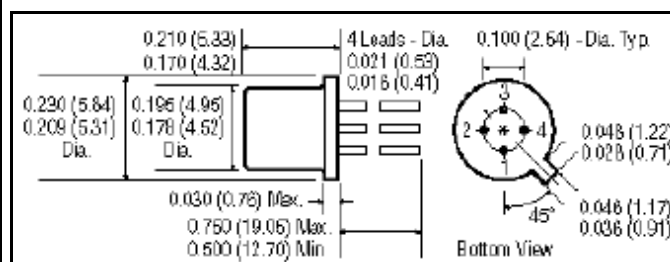
At 25 $^\circ\text{C}$ free air temperature Static Electrical Characteristics		2N5397		2N5398		Process NJ26L		
		Min	Max	Min	Max	Unit	Test Conditions	
Gate Source Breakdown Voltage	$V_{(BR)GSS}$	-25		-25		V	$I_G = -1 \mu\text{A}$, $V_{DS} = 0 \text{ V}$	
Gate Reverse Current	I_{GSS}		-0.1 -0.1		-0.1 -0.1	nA uA	$V_{GS} = -15 \text{ V}$, $V_{DS} = 0 \text{ V}$	150 $^\circ\text{C}$
Gate Source Cutoff Voltage	$V_{GS(OFF)}$	-1	-6	-1	-6	V	$V_{DS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 1 \text{ nA}$	
Gate Source Forward Voltage	$V_{GS(F)}$		1		1	V	$V_{DS} = 0 \text{ V}$, $I_G = 1 \text{ mA}$	
Drain Saturation Current (pulsed)	I_{DSS}	10	30	5	40	mA	$V_{DS} = 10 \text{ V}$, $V_{GS} = 0 \text{ V}$	

Dynamic Electrical Characteristics

Common-Source Forward Transconductance	g_{fs}	5.5	9	5	10	mS	$V_{DG} = 10 \text{ V}$, $I_D = 10 \text{ mA}$	$f = 450$ MHz
Common-Source Forward Transfer Admittance	$ Y_{fs} $	6	10	5.5	10	mS	$V_{DS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 10 \text{ mA}$	$f = 1$ kHz
Common-Source Output Conductance	$ g_{os} $		0.4		0.5	mS	$V_{DG} = 10 \text{ V}$, $I_D = 10 \text{ mA}$	$f = 450$ MHz
Common-Source Input Admittance	$ Y_{is} $		0.2		0.4	mS	$V_{DS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 10 \text{ mA}$	$f = 1$ kHz
Common-Source Input Conductance	g_{is}		2		3	mS	$V_{DG} = 10 \text{ V}$, $I_D = 10 \text{ mA}$	$f = 450$ MHz
Common-Source Input Capacitance	C_{iss}		5		5.5	pF	$V_{DG} = 15 \text{ V}$, $V_{GS} = 0 \text{ V}$	$f = 1$ MHz
Common-Source Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}		1.2		1.3	pF	$V_{DG} = 15 \text{ V}$, $V_{GS} = 0 \text{ V}$	$f = 1$ MHz



SOT-23: SMP5397, SMP5398
1-Source, 2-Drain, 3-Gate



TO-72: 2N5397, 2N5398
1-Source, 2-Drain, 3-Gate, 4- Case

Dimensions in
Inches (mm)



715 N. Glenville Dr., Ste. 400
Richardson, TX 75081
(972) 238-9700 Fax (972) 238-5338
www.interfet.com

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9